



| উল্লেখ | | SI-ESF-M-BIPV-GG- | M125-60 | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------|-------|-------|-------|
| হিলেকট্রিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স | | STC | | | | |
| ম্যাক্সিমাম পাওয়ার | [Pmpp] | ডবলউপা | 170 | 175 | 180 | 185 |
| শকত নিরিবাচন | [Pmpp] | ডবলউপা | 0/+5 | | | |
| ভোল্টেজে এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার | [Vmpp] | ভোল্টেজ | 30,84 | 31,20 | 31,50 | 31,92 |
| কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার | [Impp] | অ্যাম্পায়ার | 5,52 | 5,61 | 5,70 | 5,79 |
| খোলা বর্তনী ভোল্টেজ | [Voc] | ভোল্টেজ | 37,50 | 37,92 | 38,22 | 38,60 |
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট | [Isc] | অ্যাম্পায়ার | 5,78 | 5,92 | 6,03 | 6,13 |
| ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোল্টেজ | [Vsyst] | ভোল্টেজ | 1500 / 1000 | | | |
| ম্যাক্সিমাম সার্কিট ফ্রিকুয়েন্সি | [Icf] | অ্যাম্পায়ার | 15 | | | |
| এফসিয়েন্স | [ηm] | % | 15,89 | 16,34 | 16,76 | 17,25 |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | [FF] | % | 78,54 | 77,97 | 77,91 | 78,11 |
| হিলেকট্রিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স | | NMOT | | | | |
| ম্যাক্সিমাম পাওয়ার | [Pmpp] | ডবলউপা | 125 | 129 | 132 | 136 |
| ম্যাক্সিমাম পাওয়ার | [Vmpp] | ভোল্টেজ | 28,08 | 28,41 | 28,68 | 29,06 |
| ভোল্টেজে এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার | [Impp] | অ্যাম্পায়ার | 4,48 | 4,56 | 4,63 | 4,70 |
| কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার | [Voc] | ভোল্টেজ | 34,28 | 34,66 | 34,93 | 35,28 |
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট | [Isc] | অ্যাম্পায়ার | 4,69 | 4,80 | 4,89 | 4,97 |
| ম্যাক্সিমাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স | | | | | | |
| সাইজ | (X) | এমএম | 808 | | | |
| | (Y) | এমএম | 1326 | | | |
| | (Z) | এমএম | 8 | | | |
| | (অঞ্চল) | m2 | 1,07 | | | |
| ওজন | | কাজ | 18,71 | | | |
| সামন | | উপাদান | Glass | | | |
| এনক্যাপসুলেশন | | এমএম | 3,2 | | | |
| | | উপাদান | EVA | | | |
| | | এমএম | 0,38 | | | |
| কোষ | | মডেল | mono (sc-Si) | | | |
| | | সাইজ | 125 x 125 | | | |
| | | ম্যাক্সিমাম ক্যারেন্ট | 6 x 10 | | | |
| | | ক্যারেন্ট | 60 | | | |
| এনক্যাপসুলেশন | | উপাদান | EVA | | | |
| | | এমএম | 0,38 | | | |
| | | উপাদান | Glass | | | |
| বিয়ার | | এমএম | 3,2 | | | |
| | | উপাদান | Glass | | | |
| জংশন বক্স | | | | | | |
| সুরক্ষা | Grade | IP | 65 | | | |
| ভায়োল্ডেস (বাইপাস) | Bypass | ক্যারেন্ট | 5 | | | |
| ক্যাবলস | (+/ -) | ক্যারেন্ট | 2 | | | |
| | | দৈর্ঘ্য | 900 | | | |
| | | অধিকার | 4 | | | |
| কানেক্টরস | (+/ -) | মডেল | MC-T4 | | | |
| | | ক্যারেন্ট | 2 | | | |
| থার্মাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স | | | | | | |
| তাপমাত্রা সহন অর্ধ সার্কিট কারেন্ট α | [Isc] | %/°C | 0,0814 | | | |
| তাপমাত্রা সহন অর্ধ সার্কিট ভোল্টেজ β | [Voc] | %/°C | -0,391 | | | |
| তাপমাত্রা সহন অর্ধ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার γ | [Pmpp] | %/°C | -0,5141 | | | |
| তাপমাত্রা সহন অর্ধ কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার | [Impp] | %/°C | 0,1 | | | |
| তাপমাত্রা সহন অর্ধ ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার | [Vmpp] | %/°C | -0,38 | | | |
| নামমাত্রা মডেল অর্ধ সার্কিট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার | [NMOT] | %/°C | 47±2 | | | |
| টলারেন্স | | | | | | |
| ওয়ারিং টেম্পারেচার | | °C | -40/+85 | | | |
| ভোল্টেজ ইন্সোলেশন ভোল্টেজ | | V/DC | 3000 | | | |
| রিলেটিভ হিউমিডিটি | | % | 0/+100 | | | |
| ওয়ারিং রেসিস্ট্যান্স | | Pa | 2400 | | | |
| ম্যাক্সিমাম লোড-বিয়ারিং ক্যাপাসিটি | | Pa | 8000 | | | |
| সর্বোচ্চ শালার্বা প্রতিকার | | Ø | 28 | | | |
| | | m/s | 23 | | | |
| | | Ω | ≤ 0,1 | | | |
| স্বয়ংক্রিয় ক্রম | | Ω | ≥ 100 | | | |
| শ্রেণীবিভাগ | | | | | | |
| আবদন | | ক্লাস | A | | | |
| নিরাপত্তা | | ক্লাস | II | | | |
| ফায়ার রেসিস্ট্যান্স | | ক্লাস | A | | | |
| দহন | | ডিগ্রী | 1 | | | |
| উপাদান | | প্লেট | I | | | |
| সুরক্ষা | | কার্ট | 1.5 | | | |
| গ্যারান্টি | | | | | | |
| ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস | | ইয়ারস | 12 | | | |
| কর্মক্ষমতা | 90% রটে পাওয়ার কর্মক্ষমতা | ইয়ারস | 12 | | | |
| | 80% রটে পাওয়ার কর্মক্ষমতা | ইয়ারস | 25 | | | |
| বর্ণনা | | | | | | |
| সিলিকন সেল ফোটোভোল্টাইক সের মডেল mono (sc-Si), বিআইপিভি-কাচ/কাচ সিরিজ, স্থাপত্য ইন্টিগ্রেশন জন্য, নির্মাতা সোলার ইনোভা থেকে, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Wp) 170-185 W, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Vmpp) 30,84-31,92 V, ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Impp) 5,52-5,79 A, কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Voc) 37,50-38,60 V, শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) 5,78-6,13 A, এফসিয়েন্স 15,89-17,25 %, নিয়ে গঠিত 60 কোষ, সামনের স্তর টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 3,2 এমএম, কোষের এনক্যাপসুলেশন স্তর EVA, পিছনের স্তর টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 3,2 এমএম, জংশন বক্স (ভায়োল্ডেস, ক্যাবলস 4 এমএম, 900 এমএম এবং কানেক্টরস MC-T4), ওয়ারিং টেম্পারেচার -40/+85 °C, মাত্রা 808x1326 এমএম, ওয়াইভ রেসিস্ট্যান্স 2400 Pa, ম্যাক্সিমাম লোড-বিয়ারিং ক্যাপাসিটি 8000 Pa, ওজন 18,71 কেজি | | | | | | |